

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
دانشکده مهندسی برق

طراحی و تحلیل غیر خطی و ساخت آنتن مایکرواستریپ فعال، بهبود یافته با  
استفاده از فتونیک کریستال صفحه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات (میدان)

نگارش

مسعود دهمرده

استاد راهنما

آقای دکتر ایاز قربانی

استاد مشاور

آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور

بهار ۱۳۸۸



دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
(پلی تکنیک تهران)

بسمه تعالی

تاریخ:  
شماره:

فرم اطلاعات پایان نامه  
کارشناسی - ارشد و دکترا

معاونت پژوهشی  
فرم پروژه تحصیلات تکمیلی ۷

مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی: مسعود دهمرده  
شماره دانشجویی: ۸۵۱۲۳۰۳۴  
دانشجوی آزاد  
دانشکده: برق  
بورسیه  
رشته تحصیلی: مهندسی برق  
معادل  
گروه: مخابرات - میدان

مشخصات استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ایاز قربانی  
نام و نام خانوادگی:  
درجه و رتبه: دانشیار  
درجه و رتبه:

مشخصات استاد مشاور:

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور  
نام و نام خانوادگی:  
درجه و رتبه: استاد  
درجه و رتبه:

عنوان پایان نامه به فارسی: طراحی و تحلیل غیرخطی و ساخت آنتن مایکرواستریپ فعال، بهبود یافته با استفاده از فتونیک کریستال صفحه ای

عنوان پایان نامه به انگلیسی: **Design and nonlinear analysis and fabrication of active microstrip antenna enhanced using planar photonic crystals**

نوع پروژه: کارشناسی  ارشد  دکترا   
کاربردی  بنیادی  توسعه ای  نظری   
سال تحصیلی: ۸۸

تاریخ شروع: مهر ۸۶ تاریخ خاتمه: بهار ۸۸ تعداد واحد: ۹ سازمان تأمین کننده اعتبار: مرکز تحقیقات مخابرات ایران

واژه های کلیدی به فارسی: آنتن فعال مایکرواستریپ، فتونیک کریستال صفحه ای، ساختار زمین ناقص

واژه های کلیدی به انگلیسی: **Active Antenna- Microstrip Antenna- Planar photonic crystal- DGS**

مشخصات ظاهری	تعداد صفحات	تصویر <input checked="" type="radio"/> جدول <input checked="" type="radio"/> نمودار <input type="radio"/> نقشه <input type="radio"/> واژه نامه <input type="radio"/>	تعداد مراجع	تعداد صفحات ضمیمه
زبان متن	فارسی <input checked="" type="radio"/> انگلیسی <input type="radio"/>	چکیده	فارسی <input checked="" type="radio"/> انگلیسی <input type="radio"/>	۲۵
پادداشت				

نظرها و پیشنهادهای به منظور بهبود فعالیت های پژوهشی دانشگاه

استاد:

دانشجو:

امضاء استاد راهنما: تاریخ:

نسخه ۱: ارائه به معاونت پژوهشی به همراه یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه و فرم اطلاعات پایان نامه بصورت PDF همراه چاپ چکیده (فارسی انگلیسی) و فرم اطلاعات پایان نامه  
نسخه ۲: ارائه به کتابخانه دانشکده (به همراه نسخه الکترونیکی فرم و دو جلد پایان نامه و لوح فشرده طبق نمونه اعلام شده در صفحه خانگی کتابخانه)

اللهم عجل لوليک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه  
تقدیم به پدر و مادر عزیزم.  
تقدیم به همه آنان که دوستشان دارم.

با تشکر فراوان از زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور، جناب آقای دکتر قربانی، جناب آقای دکتر عبدی پور، همچنین اساتید محترم هیئت داورى جناب آقای دکتر راشد و جناب آقای دکتر توکلی که زحمت داورى این پایان نامه را تقبل کردند. همچنین با تشکر از همه دوستان عزیز که به هر نحوی من را در انجام این پروژه یاری کردند.

## چکیده

آنتن های فعال یکپارچه آنتن هایی هستند که در آن ها اجزای فعال به صورت مستقیم با ساختار آنتن مجتمع شده اند و خاصیت مورد نظر را به دست می دهند. در چنین ساختارهایی آنتن میکرواستریپ همزمان به عنوان بار (در ورودی و یا خروجی، بسته به نوع عملکرد مدار) و همچنین تشعشع کننده رفتار می کند. یکی از مزایای چنین آنتن هایی نسبت به آنتن های عادی، کاهش قابل ملاحظه تلفات است. از مزایای دیگر می توان به کاهش حجم و ابعاد مجموعه، قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه های کمتر ساخت اشاره نمود.

استفاده از ساختارهای متناوب جهت کنترل و تاثیر گذاری مطلوب بر امواج الکترومغناطیسی از دیرباز مرسوم بوده است. شبکه های متناوب در کاربردهای آنتنی به کریستالهای فتونی معروفند. کریستالهای فتونی به دسته ای از ساختارهای متناوب فلزی، عایقی و یا ترکیبی از این دو گفته می شود که با تناوب مشخص در حوزه مکان با الگوی یک بعدی، دو بعدی یا سه بعدی تکرار شده و در برخی باندهای فرکانسی، در یک یا چند جهت از خود باندهای ممنوعه (bandgap) نشان می دهند. در این پروژه برای اولین بار با بکارگیری ساختارهای کریستال فتونی در آنتن فعال مجتمع توانستیم بطور همزمان پارامترهای مختلف قسمت فعال مداری از جمله هارمونیک های فرعی و اندازه مدار فعال و همچنین پارامترهای قسمت آنتنی مانند سطح هارمونیک های دوم و سوم و ابعاد آنتن و بهره را بهبود ببخشیم. در این پروژه دو آنتن فعال مجتمع بهبود یافته در دو حالت گیرندگی و فرستندگی طراحی، شبیه سازی و ساخته شد. در مرحله اول یک آنتن فعال در فرکانس کاری 3 GHz و در حالت گیرندگی طراحی و ساخته شد. از آنجا که آنتن فعال بصورت مجتمع طراحی شده است، شبکه تطبیق ورودی تقویت کننده حذف شد و بجای آن آنتن طراحی شده با امپدانس برابر با امپدانس ورودی این شبکه تطبیق طراحی و جایگزین شد. بهینه سازیهای مختلفی بر روی این آنتن مجتمع انجام شده است. در قسمت دوم پروژه آنتن فعال دیگری را برای کار در فرکانس 10 GHz و در حالت فرستندگی طراحی کردیم. در قسمت فعال از یک تقویت کننده متقارن باند X استفاده شد. با استفاده از ساختار زمین ناقص در شبکه تطبیق خروجی این تقویت کننده، سطح هارمونیک دوم و سوم را به ترتیب به اندازه 11 dB و 7 dB کاهش داده و حجم مدار نیز تا حد 20٪ کاهش پیدا کرده است. با استفاده از یک آرایه 2 در 2 کریستال فتونی مربعی شکل و یک ساختار زمین ناقص، بهینه سازی بر روی پچ انجام شد که شامل کاهش اندازه حدود 15٪ و افزایش بهره می باشد.

## فهرست مطالب

مقدمه	۹
۱-۱ آنتن های فعال	۱۰
۲-۱ کریستال های فتونی: معرفی، تاریخچه و کاربرد	۱۰
۳-۱ کاربرد کریستال های فتونی در آنتن فعال	۱۴
۴-۱ ساختار پایان نامه	۱۵
مقدمه ای بر آنتن های میکرواستریپ	۱۸
۱-۲ مقدمه ای بر آنتن های میکرواستریپ	۱۹
۲-۲ روش های تغذیه آنتن میکرواستریپ	۲۰
۱-۲-۲ روش تغذیه با خط میکرواستریپ	۲۱
۲-۲-۲ روش تغذیه با خط هم محور	۲۲
۳-۲-۲ روش تغذیه تزویج روزنه ای	۲۳
۴-۲-۲ روش تغذیه مجاورتی	۲۴
۳-۲ تحلیل آنتن میکرواستریپ	۲۵
۱-۳-۲ روشهای تحلیل آنتن میکرواستریپ	۲۶
۲-۳-۲ پچ مستطیلی	۲۶
۳-۳-۲ مدل خط انتقال برای پچ مستطیلی	۲۷
۴-۲ امواج سطحی	۳۰
کریستال های فتونی و ساختار زمین سوراخ شده	۳۱
۱-۳ کریستال های فتونی	۳۲
۲-۳ تاثیر شکل پترن در رفتار کریستال فتونی صفحه ای	۳۴
۱-۲-۳ مقدمه	۳۴
۲-۲-۳ کریستال فتونی یک بعدی مربعی شکل با توزیع یکنواخت	۳۴
۳-۲-۳ کریستال فتونی یک بعدی مربعی شکل با توزیع دو جمله ای	۳۸
۴-۲-۳ توزیع دو جمله ای	۳۸
۵-۲-۳ کریستال فتونی یک بعدی مربعی شکل با توزیع دو جمله ای	۳۹
۶-۲-۳ دو فیلتر پشت سر هم بسته شده کریستال فتونی صفحه ای با توزیع دو جمله ای	۴۵

- ۴۶.....۲-۳-۷ نتیجه گیری.....
- ۴۶.....۳-۳ ساختار زمین ناقص (DGS).....
- ۴۶.....۳-۳ معرفی ساختار زمین ناقص.....
- ۴۷.....۳-۳ کاربردهای ساختار زمین ناقص.....
- ۴۹.....طراحی آنتن فعال.....
- ۵۰.....۱-۴ طراحی تقویت کننده گیرنده.....
- ۵۰.....۱-۴ مشخصات ترانزیستور.....
- ۵۰.....۲-۱-۴ طراحی مدارات بایاس DC.....
- ۵۱.....۳-۱-۴ مسائل مربوط به پایداری و طراحی تقویت کننده اولیه.....
- ۵۵.....۴-۱-۴ راه حل پیشنهادی برای بهبود پارامترهای تقویت کننده پایدار شده.....
- ۶۰.....۲-۴ تحلیل غیر خطی.....
- ۶۰.....۱-۲-۴ روشهای تحلیل مدارهای غیر خطی.....
- ۶۰.....۱-۲-۴ روشهای حوزه زمان.....
- ۶۱.....۲-۲-۴ روش حوزه زمان - فرکانس ( روش توازن هارمونیکي ).....
- ۶۱.....۳-۱-۲-۴ روش حوزه فرکانس ( روش سری ولترا ).....
- ۶۲.....۲-۲-۴ تحلیل غیر خطی تقویت کننده به روش توازن هارمونیکي.....
- ۶۴.....۳-۴ طراحی آنتن.....
- ۶۵.....۱-۳-۴ طراحی آنتن اولیه.....
- ۷۳.....۲-۳-۴ طراحی ساختار زمین ناقص.....
- ۷۵.....۳-۳-۴ طراحی آنتن بهبود یافته به کمک ساختار زمین ناقص.....
- ۸۲.....۴-۴ طراحی و شبیه سازی تقویت کننده قدرت در باند X.....
- ۸۲.....۱-۴-۴ معرفی تقویت کننده توان.....
- ۸۴.....۲-۴-۴ بکارگیری ساختار زمین ناقص در تقویت کننده.....
- ۹۱.....۳-۴-۴ تحلیل غیر خطی.....
- ۹۴.....۵-۴ طراحی آنتن در باند X.....
- ۹۴.....۱-۵-۴ طراحی آنتن مرجع در باند X.....
- ۹۷.....۲-۵-۴ طراحی آرایه کریستال فتونی دو بعدی.....
- ۹۸.....۳-۵-۴ طراحی آنتن بهبود یافته به کمک کریستال فتونی متناوب دو بعدی.....
- ۹۹.....۴-۵-۴ کاهش هارمونیک دوم آنتن بهبود یافته به کمک ساختار زمین ناقص.....



۱۰۳.....	نتایج ساخت و اندازه گیری ها.....
۱۰۴.....	۱-۵ ساخت و اندازه گیری آنتن فعال مجتمع در حالت گیرندگی.....
۱۰۶.....	۲-۵ ساخت و اندازه گیری آنتن فعال مجتمع در حالت فرستندگی.....
۱۱۱.....	نتیجه گیری و پیشنهادات.....
۱۱۴.....	ضمائم.....
۱۱۴.....	ضمیمه ۱: تعیین نقطه کار ترانزیستور.....
۱۱۶.....	انتخاب نقطه کار.....
۱۱۹.....	ضمیمه ۲: طراحی تقویت کننده کلاس A.....
۱۲۰.....	طراحی تقویت کننده کلاس A.....
۱۲۱.....	پایداری.....
۱۲۱.....	تعیین امپدانس بار و نقطه کار.....
۱۲۳.....	تعیین امپدانس ورودی و بهینه سازی طرح با کمک نرم افزار.....
۱۲۴.....	طراحی بخشهای مختلف تقویت کننده در برد مایکرواستریپ و نتایج شبیه سازی.....
۱۲۷.....	نتایج شبیه سازی تقویت کننده منفرد، به کمک نرم افزار.....
۱۲۸.....	معرفی تقویت کننده های متوازن.....
۱۲۹.....	طراحی کوپلر هیبرید ویلکینسون.....
۱۳۲.....	نتایج شبیه سازی تقویت کننده متوازن، به کمک نرم افزار.....
۱۳۴.....	ضمیمه ۳: کاتالوگ ترانزیستور NE4210S01.....
۱۴۰.....	منابع.....

# فصل اول

## مقدمه

آنتن های فعال یکپارچه<sup>۱</sup> آنتن هایی هستند که در آن ها اجزای فعال به صورت مستقیم با ساختار آنتن مجتمع شده اند و خاصیت مورد نظر را به دست می دهند. در چنین ساختارهایی آنتن مایکرواستریپ همزمان به عنوان بار (در ورودی و یا خروجی، بسته به نوع عملکرد مدار) و همچنین تشعشع کننده رفتار می کند. یکی از مزایای چنین آنتن هایی نسبت به آنتن های عادی که در آن ها هر جزء مستقلا تولید و سپس از طریق خطوط انتقال متصل می شود، کاهش قابل ملاحظه تلفات است. این امر به ویژه در فرکانس های بالا و همچنین در گیرنده های کم نویز اهمیت بیشتری می یابد. از مزایای دیگر می توان به کاهش حجم و ابعاد مجموعه، قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه های کمتر ساخت اشاره نمود.

آنتن های فعال کاربردهای فراوانی در مخابرات دارند که از جمله آن می توان به کارکردهای تجاری در سیستم های بی سیم، رادار و transceiver ها اشاره کرد [۱].

آنتن های اکتیو مایکرواستریپی را می توان با توجه به اینکه چه قطعات فعالی در آن ها به کار رفته، تقسیم بندی نمود. این قطعات می توانند تولید سیگنال RF، تقویت سیگنال RF و یا تبدیل فرکانس را انجام دهند. به این ترتیب بر پایه عملکرد قطعه، آنتن اکتیو را می توان در قالب کلاس اسیلاتوری<sup>۲</sup>، کلاس تقویت کننده<sup>۳</sup> و یا کلاس مبدل فرکانس<sup>۴</sup> دسته بندی کرد. البته همین اجزای پایه را می توان برای کاربردهای پیچیده تر مثل transceiver ها ترکیب کرده و مورد بهره برداری قرار داد.

## ۲-۱ کریستال های فتونی: معرفی، تاریخچه و کاربرد [۲]

استفاده از ساختارهای متناوب<sup>۵</sup> جهت کنترل و تاثیر گذاری مطلوب بر امواج الکترومغناطیسی از دیرباز مرسوم بوده است. شبکه های متناوب در کاربردهای آنتنی به کریستالهای فتونی<sup>۶</sup> معروفند. کریستالهای فتونی به دسته ای از ساختارهای متناوب فلزی، عایقی و یا ترکیبی از این دو گفته می شود که با تناوب مشخص در حوزه مکان با الگوی یک بعدی، دو بعدی یا سه بعدی تکرار شده و در برخی باندهای فرکانسی، در یک یا چند جهت از خود باندهای ممنوعه (bandgap) نشان می دهند. در این باند ها امواج تابشی از جهات مختلف به صورت مخرب با یکدیگر تداخل کرده (destructive interference) و در نتیجه انتشار آنها متوقف می شود.

<sup>۱</sup> Active Integrated Antenna (AIA)

<sup>۲</sup> Oscillator Type

<sup>۳</sup> Amplifier Type

<sup>۴</sup> Frequency Conversion Type

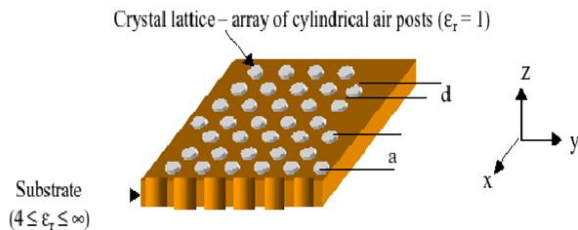
<sup>۵</sup> Periodic structures

<sup>۶</sup> Photonic crystals

کاربرد ساختارهای تناوبی الکترومغناطیسی که معمولاً با نامهای متفاوتی مانند Electromagnetic Photonic Bandgap (EBG)، Photonic Crystal (PC)، Crystal (EC) و یا Photonic Bandgap (PBG) شناخته می شوند، به دلیل خواص جالب و رفتار مناسب آنها روز به روز در حال افزایش می باشد.

با توجه به کارایی بالا و موثر کریستالهای فتونی، در سالهای اخیر مطالعات بسیار گسترده ای بر روی این دسته از ساختارهای متناوب انجام شده است. کارکرد بسیاری از قطعات میکروویو نظیر فیلترها، خطوط انتقال، موجبرها، تقویت کننده ها و به خصوص آنتنهای با کمک کریستالهای فتونی بهبود فوق العاده ای یافته و استفاده از این مواد در ادوات میکروویو به سرعت رو به گسترش است.

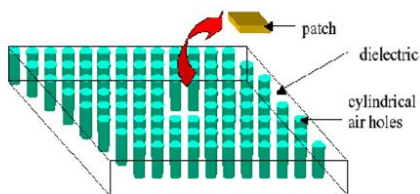
اولین ساختار کریستالی در سال ۱۹۸۷ توسط E. Yablonovitch ارائه شد. ایده اصلی، طراحی ساختاری بود که مانند کریستالهای نیمه هادی معمولی که خواص الکترونها را تحت تاثیر خود قرار می دهند، بتواند بر رفتار فوتونها تاثیرگذار باشد. Yablonovitch با ایجاد تغییرات متناوب در ضریب دی الکتریک عایقی که توسط سوراخهای مکانیکی در یک زیرلایه عایقی ایجاد کرده بود، توانست فرآیند انتشار موج در عایق را تحت کنترل قرار داده و با ایجاد یک باند فرکانسی ممنوعه از انتشار سیگنالهای میکروویو تاییده شده به عایق در کلیه جهات جلوگیری کند. چنین کریستال فتونی به نام Yablonovite شناخته می شود (شکل ۱-۱).



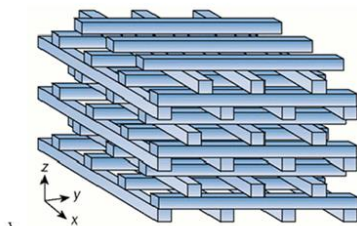
شکل (۱-۱) فتونیک کریستال Yablonovite

ممکن است اطلاق نام "کریستال فتونی" به ساختارهای مورد استفاده در رژیم میکروویو و موج میلیمتری قدری ابهام آمیز باشد. فهم این نکته ضروری به نظر می رسد که لفظ "فتونی" در این مبحث نه به معنای ارجاع به فرکانسهای نوری می باشد و نه ارتباطی با نظریه نور ذره ای دارد، بلکه استفاده از این نام به دلیل شباهت عملکرد کریستالها در دو رژیم نوری و میکروویو می باشد. در حقیقت، از دید معادلات ماکسول تنها تفاوت دو رژیم در مقیاس فرکانسی آنها می باشد و بنابراین بسیاری از ایده های مورد استفاده در رژیم نوری، مستقیماً در فرکانسهای میکروویو مورد استفاده قرار گرفته اند.

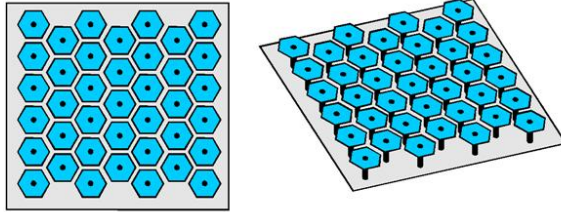
کریستال های فتونی در اشکال متفاوتی ارائه شده اند و هر کدام دارای خصوصیات ویژه ای جهت کاربردهای خاص می باشند. شکل ۱-۲ کریستال فتونی عایقی دو بعدی را که جزء اولین کریستال های فتونی مورد استفاده در آنتنهای مایکرواستریپ می باشد نشان می دهد. این ساختار از ایجاد سوراخهای مکانیکی در لایه دی الکتریک آنتن با الگوی متناوب طراحی شده برای کار در باند فرکانسی مورد نظر ساخته می شود. این سوراخها ممکن است با مواد عایقی متفاوت با زیرلایه اصلی و یا با فلز پر شوند. نشان داده شده است که برای گرفتن باند توقف یا پهنای باند قابل استفاده از این ساختار، لازم است نسبت ضریب دی الکتریک زیرلایه به ضریب دی الکتریک سوراخها حداقل ۴ باشد. چنین ساختاری می تواند به حالت سه بعدی تعمیم یابد. معروفترین کریستال فتونی عایقی سه بعدی woodpile نام دارد (شکل ۱-۳).



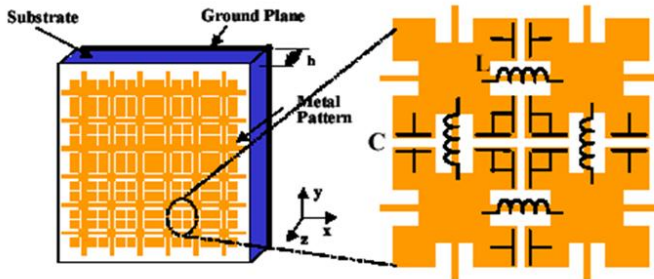
(شکل ۱-۲) کریستال فتونی عایقی دو بعدی



نوع دیگری از کریستال های فتونی که به metallo-dielectric معروفند، از پچ های مربعی (یا شش ضلعی) تشکیل شده است که هر کدام از این پچ ها، با یک میله بسیار نازک (via) به صفحه زمین متصل شده است. شکل ۱-۴ نمونه ای از این کریستال های فتونی را نشان می دهد که به mushroom-like PBG معروفند. از خواص متمایز این ساختار می توان به امپدانس بسیار بالای آن اشاره کرد. از این ساختار برای تولید آنتن مایکرواستریپ باند وسیع با پلاریزاسیون دایروی استفاده می شود.



(شکل ۴-۱) کریستال فوتونی عایقی فلزی mushroom-like



(شکل ۵-۱) کریستال فوتونی تخت فشرده (UC-PBG)

ساختار کریستال فوتونی معمولاً به دلیل اندازه فیزیکی و تناوب ساختار که تقریباً برابر نصف طول موج فرکانس باند شکاف می باشد از نظر جا و اندازه برای برخی کاربردها مشکل ساز می شود، به همین دلیل ساختارهای مسطح و فشرده کریستال فوتونی (Uniplanar Photonic Crystal) یا ساختار مسطح و فشرده بند گپ، UC-PBG (Uniplanar Compact Photonic Bandgap) در برخی کاربردها پیشنهاد شده است (شکل ۵-۱). این ساختار کریستال فوتونی از صفحات فلزی که توسط خطوط باریکی به هم وصل شده اند ( شبکه گسترده LC ) تشکیل شده اند. این ساختار دارای باند توقف وسیعی می باشد و نیازی به استفاده از چندین لایه ندارد. یکی از کاربردهای این کریستال های فوتونی در مدارهای مجتمع میکروویوی است. فیلترهای میان گذر تشکیل شده از خطوط تزویج شده دارای باندهای عبور ذاتی ناخواسته در فرکانسهای هارمونیک می باشند. جهت حذف این باندهای ذاتی ناخواسته که باعث تضعیف کارائی سیستم می شوند باید از فیلترهای دیگری استفاده کرد که این باعث اضافه شدن تلف می شود. با استفاده از کریستال های فوتونی UC-PBG در طراحی فیلترهای

مایکرواستریپ این باندهای ذاتی را می‌توان حذف نمود. باند توقف وسیع و عمیق UC-PBG جهت حذف باندهای هارمونیک مناسب است.

### ۳-۱ کاربرد کریستال های فتونی در آنتن فعال

آنتن های فعال افق های جدیدی را برای طراحی مدارات نوین مایکروویوی و موج میلیمتری فراهم کرده است. از نظر مهندسی مایکروویو، آنتن فعال از یک مدار فعال مایکروویوی (مثلا تقویت کننده کم نویز) تشکیل شده است که در دهانه ورودی یا خروجی خود بجای مدارات واسطه ۵۰ اهمی متداول، فضای آزاد را می‌بیند. در آنتن های فعال از عنصر آنتن نه تنها به عنوان عنصر تشعشع کننده استفاده می‌شود بلکه برای اعمال مختلفی نظیر فیلترینگ، تشدید کردن و ... نیز استفاده می‌شود و به عنوان یک قطعه داخلی مدار فعال در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر می‌توان از تقویت کننده های کم نویز به عنوان یکی از مهمترین قسمت های مداری در هر سیستم گیرنده بی سیم یاد کرد.

یکی از مشکلات آنتن های فعال وجود عنصر های غیر خطی در ساختار آنهاست. بدلیل وجود این عناصر همواره هارمونیک های فرعی وجود خواهند داشت. و از آنجا که راندمان مدار به شدت تحت تاثیر این هارمونیک ها قرار دارد، یافتن روش هایی برای کاهش این هارمونیک ها ضروری به نظر می‌رسد. یکی از روشهای متداول استفاده از استاب های اتصال کوتاه و مدار باز برای حذف هارمونیک های دوم و سوم است [۳]. مشکل این نوع ساختارها پهنای باند بسیار باریک و عدم توانایی تضعیف مناسب دو یا سه هارمونیک است. روشهای دیگر استفاده از ساختارهای متناوب برای حذف هارمونیک هاست. گرچه هارمونیک های فرعی در گیرنده زیاد مورد توجه نبوده است (به دلیل توان کمی که همواره در گیرنده وجود دارد) ولی می‌توان با کاهش اثرات هارمونیک ها در گیرنده، راندمان مدار را بهبود داد. همچنین مواردی از احتمال بالا رفتن سطح سیگنال دریافتی و امکان به اشباع رفتن مدارات وجود دارد. در ضمن کم بودن هارمونیک ها می‌تواند دغدغه طراح را نسبت به تولید نویز اینترمدولاسیون<sup>۱</sup> که در طبقات بعدی ممکن است بوجود بیاید مرتفع کند. با توجه به موارد یاد شده کاهش و بهبود هارمونیک های فرعی در گیرنده نیز می‌تواند در بهبود راندمان موثر باشد.

در سال ۲۰۰۱ با بکارگیری صفحه زمین دارای ساختار PBG در یک تقویت کننده کلاس AB (شکل ۱-۶) توانستند تا حدودی هارمونیک های دوم و سوم را کنترل کنند [۴].

Wang و Lin در سال ۲۰۰۳ با استفاده از ساختار دمیلی شکل کریستال های فتونی در مسیر خط تغذیه (شکل ۱-۷) تا حدودی هارمونیک های فرعی را کاهش دادند [۵].

در سال ۲۰۰۶ برای کم کردن هارمونیک دوم در اسیلاتور معرفی شده از ساختار EBG استفاده شد (شکل ۱-۸) و تضعیف ۱۰.۱۶ dB برای این هارمونیک مشاهده شد [۶].

<sup>۱</sup> Intermodulation

همانطور که گفته شد یکی از ویژگی های آنتن های فعال این است که عنصر آنتن و قسمت مدار فعال به صورت یکپارچه در نظر گرفته می شوند. بنابراین ترکیب هوشمندانه و دقیق آنتن و بخش مداری در ساختار آنتن های فعال امکانات جدیدی را می تواند فراهم می کند.

در این پروژه با بکارگیری ساختار کریستال فتونی در عنصر آنتن، علاوه بر بهبود پارامترهای آنتن نظیر بهره به دنبال حذف هارمونیک های فرعی نیز خواهیم بود. یعنی به کمک این روش بخش آنتنی و بخش مداری آنتن فعال را تواما بهبود می بخشیم.

با این توضیح که "باندهای توقف"ی که فتونیک کریستالها تامین می کنند می تواند به عنوان راه حل بسیار مناسبی برای حذف هارمونیک های فرعی مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی این فرآیند بر مبنای طراحی یک شبکه فتونیک کریستال متناسب با فرکانس هارمونیک اصلی و اعمال مناسب آن جهت تضعیف هر چه بیشتر هارمونیک های غیر اصلی قرار گرفته است. ایده اصلی طراحی بر این اصل استوار می باشد که شبکه کریستالی به نحوی طراحی شود که فرکانس هارمونیک های فرعی در محدوده "باند توقف" فتونیک کریستال قرار گیرد. در این صورت می توان این هارمونیک ها را به نحو موثری کاهش داد. حذف هارمونیک های فرعی نتایج مطلوبی نظیر افزایش راندمان، افزایش پهنای باند و ... را در مشخصه های مدار فعال به دنبال خواهد داشت.

#### ۴-۱ ساختار پایان نامه

در فصل دوم مفاهیم آنتن های مایکرواستریپ نظیر کلیات آنتن های مایکرواستریپ، روش های تغذیه آنتن مایکرواستریپ و مزایا و معایب این آنتن ها آورده شده است.

فصل سوم به معرفی فتونیک کریستال ها و ساختار زمین سوراخ شده می پردازد. در این فصل به معرفی کریستال های فتونی، تاریخچه و کاربردهای آنها اشاره می شود. در ادامه تاثیر تغییر شکل پترن آرایه کریستال فتونی صفحه ای بر پارامترهای مختلف فیلترهای مایکرواستریپی تحقق یافته به کمک کریستال های فتونی صفحه ای بررسی می شود. در نهایت به معرفی ساختار زمین ناقص (DGS)<sup>۱</sup> و معرفی یکی از کاربردهای آن به عنوان فیلتر در مدارات ماریکرویوی اشاره شده است.

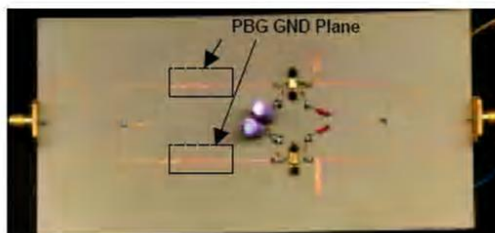
فصل چهارم به طراحی و شبیه سازی قسمت های مختلف آنتن فعال مجتمع می پردازد. در ابتدا یک آنتن فعال مجتمع به عنوان گیرنده طراحی شده و نتایج شبیه سازی آن آورده شده است. قسمت فعال این آنتن، شامل یک گیرنده می باشد که در حالت پرتوان سیگنال دریافت می کند. طراحی این گیرنده برای حداکثر بهره بوده و برای نویز کمینه طراحی نشده است. توجیه این طراحی استفاده از گیرنده ها در نزدیکی پرتنده پرتوان می باشد که توان بالایی در گیرنده وجود دارد و امکان تاثیر هارمونیک های دوم و سوم بر روی گیرنده وجود دارد. لذا برای کاهش اثر این هارمونیک ها، گیرنده برای کمترین مقدار هارمونیک دوم و سوم بهینه سازی شده است. در قسمت دوم این فصل از یک

<sup>۱</sup> Defected Ground Structure

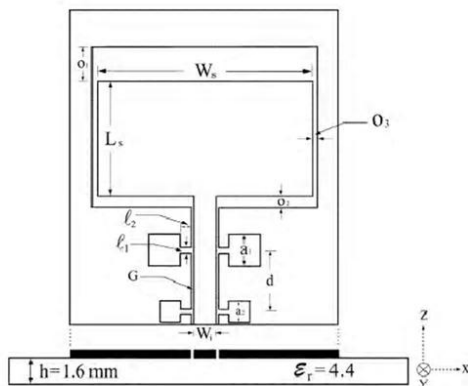


تقویت کننده بالانس باند X برای طراحی آنتن در حالت فرستندگی استفاده شده است. مزایای آنتن فعال مجتمع طراحی شده در حالت فرستندگی، داشتن بهره بالا و هارمونیک های دوم و سوم کم می باشد. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای Agilent, Momentum و IE3D که بر اساس روش MoM<sup>۱</sup> کار می کنند و همچنین نرم افزار HFSS که بر اساس روش FEM<sup>۲</sup> تحلیل می کند، استفاده شده است.

فصل پنجم، گزارشی از فاز ساخت و نتایج اندازه گیری را ارائه می دهد. مقایسه نتایج شبیه سازی شده با نتایج اندازه گیری و تایید شبیه سازی های انجام شده در ادامه فصل قابل مشاهده است. در نهایت، در فصل ششم به جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده پرداخته شده است.



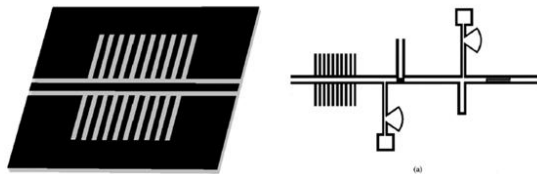
(شکل ۶-۱) تقویت کننده کلاس AB با صفحه زمین PBG [۴]



(شکل ۷-۱) آنتن شبیری با ساختار حذف کننده هارمونیک [۵]

<sup>۱</sup> Method of Moment

<sup>۲</sup> Finite Element Method



(شکل ۱-۸) ساختار اسلیاتور و قسمت حذف کننده هارمونیک ها [۶]

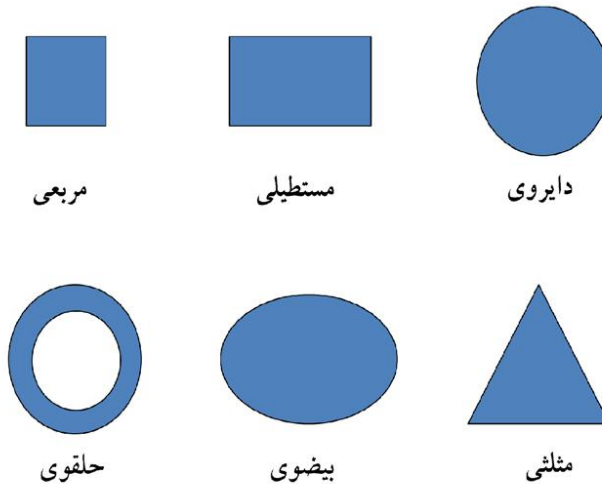
## فصل دوم

مقدمه ای بر آنتن های میکرواستریپ

## ۱-۲ مقدمه ای بر آنتن های میکرواستریپ

آنتنهای میکرواستریپ امروزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده‌اند. موضوع آنتنهای چاپی اولین بار توسط Deschamps در سال ۱۹۵۳ ارائه شد [۷]. گرچه به دلیل برخی مسائل، ساخت اولین آنتن میکرواستریپ تا سال ۱۹۷۴ محقق نشد [۸]. بعد از آن زمان، آنتنهای میکرواستریپ تحقیقات و توجهات بسیاری را به سوی خود معطوف کرد و انواع مختلفی از آنتنهای میکرواستریپ ارائه شد. آنتنهای میکرواستریپ مزایای نسبت به آنتنهای دیگر دارند. اندازه کوچکتر، هزینه ساخت کمتر و سازگاری با مدارات مجتمع مونولیتیک میکروویوی (MMIC)<sup>۱</sup> از مزایای آنهاست. بهمین دلیل، آنتنهای میکرواستریپ در کاربردهای بسیاری استفاده می‌شوند نظیر مخابرات ماهواره‌ای، ارتباطات هوایی و بین هواپیماها و ارتباطات تلفن‌های همراه، گرچه آنتنهای میکرواستریپ مزایای قابل توجهی دارند، ولی آنها دارای معایبی نظیر پهنای باند کم و راندمان تشعشعی پایین نیز می‌باشند.

اشکال متداول آنتنهای میکرواستریپ در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.



(شکل ۱-۲) اشکال متداول آنتنهای میکرواستریپ

<sup>۱</sup> Monolithic Microwave Integrated Circuit